

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局(43)国際公開日
2005年8月11日 (11.08.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/074113 A1

(51)国際特許分類:

H02M 3/28

(21)国際出願番号:

PCT/JP2004/016103

(22)国際出願日: 2004年10月29日 (29.10.2004)

(25)国際出願の言語:

日本語

(26)国際公開の言語:

日本語

(30)優先権データ:

特願2004-024563 2004年1月30日 (30.01.2004) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 株式会社村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO., LTD.) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 Kyoto (JP).

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 細谷達也 (HOSOTANI, Tatsuya) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 株式会社村田製作所内 Kyoto (JP). 竹村博 (TAKEMURA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒6178555 京都府長岡京市東神足1丁目10番1号 株式会社村田製作所内 Kyoto (JP).

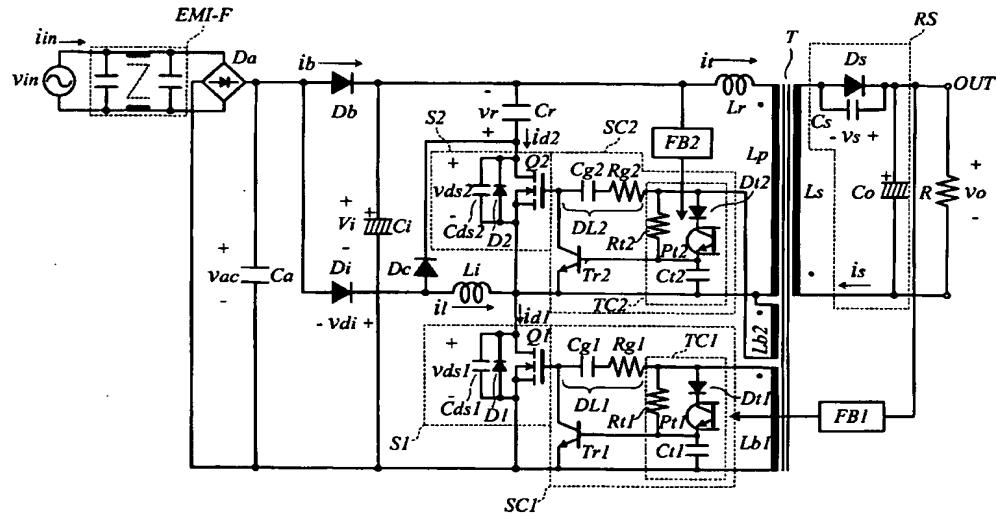
(74)代理人: 小森久夫 (KOMORI, Hisao); 〒5400011 大阪府大阪市中央区農人橋1丁目4番34号 Osaka (JP).

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,

[続葉有]

(54)Title: SWITCHING POWER SUPPLY

(54)発明の名称: スイッチング電源装置



WO 2005/074113 A1

(57) Abstract: A switching power supply comprising first and second switch circuits (S1, S2) composed of switch elements (Q1, Q2), diodes (D1, D2) and capacitors (Cds1, Cds2), and a transformer (T). A first inductor (Lr) is connected in series with the primary winding (Lp) of the transformer (T). A second inductor (Li) is provided such that the voltage of a third capacitor (Ca) is applied during the on period of the first switch circuit (S1). A diode (Di) for blocking the reverse current of the second inductor (Li), and a capacitor (Ci) charged by the exciting energy stored in the second inductor (Li) to apply a voltage to the primary winding (Lp) during the on period of the first switch circuit (S1) are also provided. Furthermore, a capacitor (Cr) is provided to form a closed loop together with the inductor (Lr), the primary winding (Lp) and the second switching circuit (S2).

(57)要約: スイッチ素子 (Q1), (Q2)、ダイオード (D1), (D2)、キャパシタ (Cds1), (Cds2) からなる第1・第2のスイッチ回路 (S1), (S2) と、トランス (T) を備え、トランス (T) の1次巻線 (Lp) に直列に第1のインダクタ (Lr) を接続し、第1のスイッチ回路 (S1) のオン期間に第3の

[続葉有]



NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

キャパシタ(Ca)の電圧が印加されるように第2のインダクタ(Li)を設ける。また(Li)に対する逆電流を阻止するダイオード(Di)と、(Li)に蓄積された励磁エネルギーにより充電され且つ(S1)のオン期間において1次巻線(Lp)に電圧を印加するキャパシタ(Ci)を設ける。さらにインダクタ(Lr)と1次巻線(Lp)と第2のスイッチ回路(S2)とともに閉ループを構成するようにキャパシタ(Cr)を設ける。

明 細 書

スイッチング電源装置

技術分野

[0001] 本発明は、入力電源からの供給電力を断続すると共にインダクタにより電力変換を行って所定の直流電圧を出力するスイッチング電源装置に関するものである。

背景技術

[0002] 一般にスイッチング電源装置の性能指標の1つとして高調波特性と力率特性がある。高調波特性はスイッチング電源装置からその入力電源ラインへ流れる高調波電流の抑制機能であり、他の機器へ悪影響を与えないように高調波電流の上限が規定されている。また、力率特性はスイッチング電源装置から入力を見た力率であり、電力系統の低損失化のためには高力率である程好ましい。

[0003] そこで、従来は特許文献1～3に開示されているような構造のスイッチング電源装置が考案されている。

特許文献1のスイッチング電源装置の構成例を図13に示す。図13において、第1のスイッチ回路S1は第1のスイッチ素子Q1、第1のダイオードD1、および第1のキャパシタC1の並列回路で構成していて、第2のスイッチ回路S2は第2のスイッチ素子Q2、第2のダイオードD2、および第2のキャパシタC2の並列回路で構成している。

[0004] Tはトランスであり、その1次巻線T1とインダクタLとの直列回路に第1のスイッチ回路S1と入力電源Eを直列に接続するとともに、第2のスイッチ回路S2とキャパシタCとの直列回路を1次巻線T1とインダクタLとの直列回路に対して並列に接続している。トランスTの2次巻線T2には整流ダイオードDsと平滑コンデンサCoからなる整流平滑回路を設けている。2次側の整流ダイオードDsには並列にキャパシタCsを接続している。検出回路14は負荷に供給される出力電圧Voおよび必要に応じて出力電流Ioを検出する。制御回路11はバイアス巻線T3の発生電圧を入力して、スイッチ素子Q1に対して正帰還をかけることによって自励発振させる。制御回路12はバイアス巻線T4の発生電圧を入力して、スイッチ素子Q2のオフタイミングを制御することによりQ2のオン期間を制御する。

[0005] 特許文献2のスイッチング電源装置の構成例を図14に示す。図14において、交流電源2から供給される交流電圧を整流器4で整流し、平滑コンデンサ6で平滑することによって得られる整流電圧Vinを、第1の電力変換部8および第2の電力変換部10へ供給するようにしている。スイッチングトランジスタQsがオンになると、整流電圧VinがチョークコイルCHとダイオードDbおよび高周波トランスTの1次巻線L1に加わり、チョークコイルCHにエネルギーが蓄積される。スイッチングトランジスタQsがオフすると、チョークコイルCHのエネルギーによりダイオードDc、1次巻線L1、およびコンデンサC1を通って電流が流れ。このスイッチングトランジスタQsのオンオフ動作を繰り返すことによって、トランスTの2次巻線L2に誘起した電圧をダイオードD2とコンデンサCoで平滑化して直流電圧Voを出力する。パルス幅制御回路16は出力電圧Voの変動に応じてスイッチングトランジスタQsの通電時間制御を行ってVoを安定化させる。

[0006] 特許文献3のスイッチング電源装置の構成例を図15に示す。図15において、全波整流回路2は入力端子1-1'から交流入力電圧を入力して整流電圧Eiを出力する。第1のコンデンサ3はインダクタ20の電流を第2のスイッチング素子6と第2のコンデンサ7を介して平滑し、直流電圧E3を供給する。第1のスイッチング素子4は前記整流電圧Eiをインダクタ20を介して、さらに第1のコンデンサ7の直流電圧E3をトランス5の1次巻線51を介して、高周波スイッチングにより交流電圧に変換する。第2のスイッチング素子6と第1のスイッチング素子4は制御回路11により交互にオンオフされる。第2のコンデンサ7は第2のスイッチング素子6のオン期間にトランス5に蓄積された励磁エネルギーの一部とインダクタ20の電流を吸収し放送出する。ダイオード8とコンデンサ9は整流平滑回路を構成し、2次巻線52に発生する高周波交流電圧のフライバック電圧を整流平滑し、直流出力電圧Eoを出力端子10-10'へ出力する。制御駆動回路11は直流出力電圧Eoを検出して第1のスイッチング素子4および第2のスイッチング素子6のオンオフ比を制御する。

特許文献1:特開平11-187664号公報

特許文献2:特開平4-21358号公報

特許文献3:特開平7-75334号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

[0007] ところが、特許文献1では、電圧クランプ回路により、ゼロ電圧スイッチング動作(以下ZVS動作という。)が行われ、高効率化を図ることができるが、高調波電流抑制機能はない。

特許文献2では、高調波電流抑制機能を有するが、ZVS動作を行わないのでスイッチング損失が大きく回路効率が悪い。

[0008] 特許文献3では、電圧クランプ回路により、ZVS動作が行われ、高調波電流抑制機能も有するが、スイッチング動作により発生する電流が商用交流電圧を整流するダイオード(図15に示した全波整流回路2)に流れるため、そのダイオードでの損失が大きく、高調波電流の低減効果も小さい。そのため、商用交流電源ラインにローパスフィルタを設ける必要があり、スイッチング電源装置が大型化する。また、瞬時停電などにより商用交流電源が一時的に遮断された時にも出力を供給し続けられる時間(出力保持時間)を確保するためのコンデンサ3の電圧が制御されないため、その電圧が軽負荷時に大きく上昇し、部品の耐圧を超えるおそれがあるという問題がある。

[0009] そこで、この発明の目的は、高調波電流の低減効果を高め、高調波特性および功率特性を改善するとともに、より高効率化を図ったスイッチング電源装置を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0010] (1)この発明のスイッチング電源装置は、第1のスイッチ素子Q1、第1のダイオードD1、および第1のキャパシタCds1の並列回路で構成された第1のスイッチ回路S1と、第2のスイッチ素子Q2、第2のダイオードD2、および第2のキャパシタCds2の並列接続回路で構成された第2のスイッチ回路S2と、交流入力電圧を整流する少なくとも1つの整流素子により構成された入力側整流回路Daと、該整流回路Daにより整流された電圧が印加される第3のキャパシタCaと、1次巻線Lpと2次巻線Lsを有するトランジスタTと、その2次巻線Lsに接続された整流平滑回路RSと、1次巻線Lpに直列に接続された第1のインダクタLrと、第1のスイッチ回路S1が導通状態となるオン期間に第3のキャパシタCaの電圧が印加されるように接続された第2のインダクタLiと、該第

2のインダクタLiに逆電流が流れるのを阻止する第3のダイオードDiと、第2のインダクタLiに蓄えられた励磁エネルギーにより充電され、且つ、第1のスイッチ回路S1のオン期間に1次巻線Lpに電圧を印加するように接続された第4のキャパシタCiと、第1のインダクタLrと1次巻線Lpと第2のスイッチ回路S2とともに閉ループを構成する第5のキャパシタCrと、第1・第2のスイッチ素子を両スイッチ素子が共にオフする期間を挟んで交互にオンオフ駆動するスイッチング制御回路SC1, SC2とを備えたことを特徴としている。

[0011] (2)この発明のスイッチング電源装置は、第1のスイッチ素子Q1、第1のダイオードD1、および第1のキャパシタCds1の並列接続回路で構成された第1のスイッチ回路S1と、第2のスイッチ素子Q2、第2のダイオードD2、および第2のキャパシタCds2の並列接続回路で構成された第2のスイッチ回路S2と、交流入力電圧を整流する少なくとも1つの整流素子により構成された入力側整流回路Daと該整流回路Daにより整流された電圧が印加される第3のキャパシタCaと、1次巻線Lpと2次巻線Lsを有するトランストと、その2次巻線Lsに接続された整流平滑回路RSと、1次巻線Lpに直列に接続された第1のインダクタLrと、第1のスイッチ回路S1が導通状態となるオン期間に第3のキャパシタCaの電圧が印加されるように接続された第2のインダクタLiと、該第2のインダクタLiに逆電流が流れるのを阻止する第3のダイオードDiと、第2のインダクタLiに蓄えられた励磁エネルギーにより充電され、且つ、前記オン期間に1次巻線Lpに電圧を印加するように接続された第4のキャパシタCiと、第1のスイッチ回路S1の両端に接続される直列回路を第2のスイッチ回路S2とで構成する第5のキャパシタCrと、第1・第2のスイッチ素子を両スイッチ素子が共にオフする期間を挟んで交互にオンオフ駆動するスイッチング制御回路SC1, SC2とを備えたことを特徴としている。

[0012] (3)この発明のスイッチング電源装置は、(1)または(2)において、トランストとは別の第2のトランスト2を設け、第2のインダクタLiを第2のトランスト2の入力巻線で構成し、第2のトランスト2の出力巻線Loと前記整流平滑回路RSとの間に整流回路Ds2を設けたことを特徴としている。

[0013] (4)この発明のスイッチング電源装置は、(1)または(2)において、トランストとは別

の第2のトランスト2を設け、第2のインダクタLiと直列に第2のトランスト2の入力巻線Li1を接続し、第2のトランスト2の該出力巻線と前記整流平滑回路との間に整流回路を設けたことを特徴としている。

- [0014] (5)この発明のスイッチング電源装置は、(1)または(2)において、トランストに3次巻線Ltを設け、第2のインダクタLiと直列に接続したことを特徴としている。
- [0015] (6)この発明のスイッチング電源装置は、(1)～(5)において、第3のキャパシタCaが高調波成分の電流を遮断するローパスフィルタまたはローパスフィルタの一部を構成していることを特徴としている。
- [0016] (7)この発明のスイッチング電源装置は、(1)～(6)において、入力側整流回路Daと第4のキャパシタCiとの間に第4のダイオードDbを接続したことを特徴としている。
- [0017] (8)この発明のスイッチング電源装置は、(1)～(7)において、第1のスイッチ回路S1と第2のスイッチ回路S2との接続点に第2のインダクタLiの一端を接続し、他端を第3のダイオードDiに接続し、第2のスイッチ回路S2と第4のキャパシタCrとの接続点と第1のスイッチ回路S1と第2のスイッチ回路S2との接続点に、第4のダイオードDcの両端を接続したことを特徴としている。
- [0018] (9)この発明のスイッチング電源装置は、(1)～(8)において、トランストに単数または複数の駆動巻線Lb1, Lb2を設け、前記スイッチング制御回路SC1, SC2が前記駆動巻線Lb1, Lb2に発生する電圧を用いて第1のスイッチ素子Q1または第2のスイッチ素子Q2を駆動することを特徴としている。
- [0019] (10)この発明のスイッチング電源装置は、(1)～(9)において、駆動巻線Lb1, Lb2と第1・第2のスイッチング素子Q1, Q2の制御端子との間に抵抗Rg1, Rg2とコンデンサCg1, Cg2との直列回路からなる遅延回路DL1, DL2を備え、前記スイッチング制御回路SC1, SC2が前記駆動巻線Lb1, Lb2に前記スイッチ素子Q1, Q2をターンオンさせる電圧が発生してから遅延して該スイッチ素子Q1, Q2をターンオンさせることを特徴としている。
- [0020] (11)この発明のスイッチング電源装置は、(10)において、第1・第2のスイッチ素子Q1, Q2の両端に印加される電圧が零電圧または零電圧付近まで低下してからターンオンするように前記遅延回路DL1, DL2の遅延時間を設定したことを特徴としている。

る。

[0021] (12)この発明のスイッチング電源装置は、(1)ー(11)において、スイッチング制御回路SC1, SC2が、駆動巻線Lb1, Lb2にスイッチ素子Q1, Q2をターンオンさせる電圧が発生してから所定時間後にオンすることによりスイッチ素子Q1, Q2をターンオフさせることを特徴としている。

[0022] (13)この発明のスイッチング電源装置は、(12)において、スイッチ手段をトランジスタTr1, Tr2で構成し、該トランジスタTr1, Tr2の制御端子に時定数回路を構成するインピーダンス回路およびコンデンサCt1, Ct2がそれぞれ接続されたことを特徴としている。

[0023] (14)この発明のスイッチング電源装置は、(1)ー(13)において、スイッチング制御回路SC1, SC2は、駆動巻線Lb1, Lb2にスイッチ素子Q1, Q2をターンオンさせる電圧が発生してから、一定時間後にスイッチ素子Q1, Q2をターンオフさせるように時定数回路TC1, TC2を備えたことを特徴としている。

[0024] (15)この発明のスイッチング電源装置は、(1)ー(14)において、トランスTの有する漏れインダクタンスを第1のインダクタLrとして構成したことを特徴としている。

[0025] (16)この発明のスイッチング電源装置は、(1)ー(15)において、第1のスイッチ回路S1または第2のスイッチ回路S2の少なくとも一方を電界効果トランジスタで構成したことを特徴としている。

[0026] (17)この発明のスイッチング電源装置は、(1)ー(16)において、スイッチング制御回路SC1, SC2が、2次巻線Lsに接続された整流平滑回路RSから得られる出力電圧を安定化するように第1のスイッチ素子Q1のオン期間を制御することを特徴としている。

[0027] (18)この発明のスイッチング電源装置は、(1)ー(17)において、スイッチング制御回路SC1, SC2が、第4のキャパシタCiの両端電圧に応じて第2のスイッチ素子Q2のオン期間を制御することを特徴としている。

[0028] (19)この発明のスイッチング電源装置は、(1)ー(18)において、スイッチング制御回路SC1, SC2が、第4のキャパシタCiの両端電圧の上昇に応じて第2のスイッチ素子Q2のオン期間を抑制し、軽負荷または無負荷時に発振期間と停止期間を周期的

に繰り返す間欠発振動作モードに移行して、第4のキャパシタCiの両端電圧の上昇を抑制することを特徴としている。

発明の効果

[0029] (1)この発明によれば、第1のスイッチ素子Q1と第2のスイッチ素子Q2がゼロ電圧スイッチング動作することによりスイッチング損失が大幅に低減される。また、入力される半波整流電圧または全波整流電圧をスイッチングして整流電圧に比例した電流を流すので、電流のピーク値が正弦波状となって高効率が得られる。また、第2のインダクタLiへの逆電流を阻止する第3のダイオードDiは特許文献3のように商用交流電圧の整流とスイッチング電流の整流の双方を行う必要が無く、スイッチング電流のみを整流すればよいので、高速スイッチング機能を満たして低損失化が図れる。さらに、入力側整流回路Daには特許文献3のように商用交流電圧を整流するダイオードに高周波電流が流れないので高調波電流抑制機能が低下することもない。

[0030] (2)この発明によれば、第1のスイッチ回路S1の両端に接続される直列回路を第2のスイッチ回路S2とで構成する第5のキャパシタCrと、第1・第2のスイッチ素子を両スイッチ素子が共にオフする期間を挟んで交互にオンオフ駆動するスイッチング制御回路SC1, SC2とを備えたことにより、第5のキャパシタCrの印加電圧を大きくすることによって第5のキャパシタCrの容量を低減できる。

[0031] (3)この発明によれば、第2のトランスT2の入力巻線を第2のインダクタLiとし、第2のトランスT2の出力巻線を整流回路を介して整流平滑回路に接続したことにより、第2のトランスT2の入力巻線に蓄えられたエネルギーを第2のトランスT2により2次側に直接供給でき、トランスTの電流が減少し、導通損失を低減でき、さらに高効率化が図れる。

[0032] (4)この発明によれば、第2のインダクタLiに直列に第2のトランスT2の入力巻線Li1を接続し、第2のトランスT2の出力巻線と整流回路との間を別の整流回路を介して接続したことにより、第2のインダクタLiに印加される電圧を調整し入力電流の導通角を広げて高調波電流をさらに抑制でき、または逆に導通角を狭めてキャパシタCiの電圧上昇を抑制できる。

[0033] (5)この発明によれば、トランスTの3次巻線Ltを第2のインダクタLiに直列接続した

ことにより、Liに印加される電圧を調整して入力電流の導通角を広げて高調波電流をさらに抑制したり、逆に導通角を狭めてキャパシタCiの電圧上昇を抑制できる。

- [0034] (6)この発明によれば、第3のキャパシタCaが第1・第2のスイッチ素子Q1, Q2のスイッチングによる高周波電流の入力電源ライン側への伝搬を防止するので、大きな高調波電流抑制効果が得られる。
- [0035] (7)この発明によれば、入力側整流回路Daと第4のキャパシタCiとの間に第4のダイオードDbを接続したことにより、起動時に第4のキャパシタCiに対して直接充電でき、定常状態に到るまでのトランジスタの偏磁現象等を防止することができる。
- [0036] (8)この発明によれば、第1のスイッチ回路S1がオフの期間に第4のダイオードDcと第2のスイッチ回路S2によって第2のインダクタLiを短絡することになるので、このインダクタLiに流れる電流が0となって第3のダイオードDiに印加される電圧を大幅に低減できる。そのため、この第3のダイオードDiとして低耐圧のものを使用できるようになる。
- [0037] (9)この発明によれば、トランスTに駆動巻線Lb1, Lb2を設け、その駆動巻線Lb1, Lb2に発生する電圧を用いて第1・第2のスイッチ素子Q1, Q2を駆動するようにしたことにより、自励発振動作が可能となる。
- [0038] (10)この発明によれば、遅延回路DL1, DL2を設け、前記駆動巻線Lb1, Lb2にスイッチ素子Q1, Q2をターンオンさせる電圧が発生してから遅延させてQ1, Q2をターンオンさせるようにしたことにより、デッドタイムが形成され、第1・第2のスイッチ素子Q1, Q2を適切なタイミングで交互にオンオフ駆動することができる。
- [0039] (11)この発明によれば、第1・第2のスイッチ素子Q1, Q2の両端に印加される電圧が零電圧または零電圧付近まで低下してからターンオンするように前記遅延回路DL1, DL2の遅延時間を設定したことにより、ゼロ電圧スイッチング動作することになり、スイッチング損失を低減して高効率化を図れる。
- [0040] (12)この発明によれば、前記スイッチング制御回路SC1, SC2にスイッチ素子Q1, Q2をターンオフさせるスイッチ手段を備えたことにより、スイッチング制御回路SC1, SC2の構成が簡単となり、少ない部品点数でスイッチング制御が可能となる。
- [0041] (13)この発明によれば、前記スイッチ手段をトランジスタTr1, Tr2で構成し、時定

数回路を構成したことにより、第1・第2のスイッチ素子Q1, Q2のオン期間の設定が容易となる。

[0042] (14)この発明によれば、時定数回路TC1, TC2の作用により、駆動巻線Lb1, Lb2にスイッチ素子Q1, Q2をターンオンさせる電圧が発生してから一定時間後にQ1, Q2がターンオフするので、ターンオフさせるタイミングを適切に設定してスイッチ素子Q1, Q2のオン期間を定めることができる。

[0043] (15)この発明によれば、トランジスタの漏れインダクタンスを第1のインダクタLrとして利用することにより部品点数が削減できる。

[0044] (16)この発明によれば、第1のスイッチ回路S1または第2のスイッチ回路S2の少なくとも一方を電界効果トランジスタで構成したことにより、ダイオードD1, D2を寄生ダイオードで、キャパシタCds1, Cds2を寄生キャパシタでそれぞれ構成でき、スイッチ素子Q1, Q2、ダイオードD1, D2、およびキャパシタCds1, Cds2の並列接続回路を少ない部品点数で構成できる。

[0045] (17)この発明によれば、第1のスイッチ素子Q1のオン期間制御により出力電圧が安定化するので、定電圧電源装置が得られる。

[0046] (18)この発明によれば、第4のキャパシタCiの両端電圧に応じて第2のスイッチ素子Q2のオン期間が制御されるので、定電圧電源装置が得られる。

[0047] (19)この発明によれば、スイッチング制御回路SC1, SC2が第4のキャパシタCiの両端電圧の上昇に応じて第2のスイッチ素子Q2のオン期間を抑制し、軽負荷または無負荷時に間欠発振動作モードに移行して、第4のキャパシタCiの両端電圧の上昇を抑制するようにしたので、第4のキャパシタCiの破損を防止するとともに、その低耐圧化および、スイッチ素子Q1, Q2, 2次側の整流ダイオードDsの低耐圧化が図れる。

図面の簡単な説明

[0048] [図1]第1の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。

[図2]同スイッチング電源装置の各部の波形図である。

[図3]入力電圧、入力電流、およびインダクタに流れる電流波形を示す図である。

[図4]第2の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。

[図5]第3の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。

[図6]第4の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。

[図7]第5の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。

[図8]第6の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。

[図9]第7の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。

[図10]第8の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。

[図11]第9の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。

[図12]第10の実施形態に係るスイッチング電源装置のスイッチング制御回路の例を示す図である。

[図13]従来のスイッチング電源装置の回路図である。

[図14]従来のスイッチング電源装置の回路図である。

[図15]従来のスイッチング電源装置の回路図である。

符号の説明

[0049] EMI-F -EMIフィルタ

Da-入力側整流回路

Q1-第1のスイッチ素子

D1-第1のダイオード

Cds1-第1のキャパシタ

S1-第1のスイッチ回路

Q2-第2のスイッチ素子

D2-第2のダイオード

Cds2-第2のキャパシタ

S2-第2のスイッチ回路

Ca-第3のキャパシタ

T-トランス

Lp-1次巻線

Ls-2次巻線

Lb1, Lb2-駆動巻線

Ds—整流ダイオード
Co—平滑コンデンサ
RS—整流平滑回路
Lr—第1のインダクタ
Li—第2のインダクタ
Cr—第5のキャパシタ
Ci—第4のキャパシタ
SC1—第1のスイッチング制御回路
SC2—第2のスイッチング制御回路
Db—第4のダイオード
Di—第3のダイオード
Tr1, Tr2—トランジスタ
DL1, DL2—遅延回路
FB1, FB2—帰還回路
TC1, TC2—時定数回路

発明を実施するための最良の形態

[0050] 第1の実施形態に係るスイッチング電源装置について図1ー図3を参照して説明する。

図1はスイッチング電源装置の回路図である。図1においてVinは商用交流電源である。入力側整流回路Daはダイオードブリッジからなり、EMIフィルタEMI-Fを介して商用交流電源Vinを全波整流する。第1のスイッチ回路S1は、第1のスイッチ素子Q1、第1のダイオードD1、第1のキャパシタCds1からなる。同様に第2のスイッチ回路S2は、第2のスイッチ素子Q2、第2のダイオードD2、第2のキャパシタCds2からなる。これらのダイオードD1, D2はFETであるスイッチ素子Q1, Q2の寄生ダイオード、キャパシタCds1, Cds2はQ1, Q2の寄生キャパシタである。但し、必要な特性を得るためにQ1, Q2とは別にD1, D2, Cds1, Cds2を付加してもよい。

[0051] 入力側整流回路Daの整流電圧は第3のキャパシタCaに印加される。トランスTは1次巻線Lp、2次巻線Ls、駆動巻線Lb1, Lb2を備えている。トランスTの2次巻線Ls

には整流ダイオードDsと平滑コンデンサCoからなる整流平滑回路RSを接続している。整流ダイオードDsにはトランジストの電圧が反転するときの共振用のコンデンサCsを並列接続している。このコンデンサCsとしては整流ダイオードDsの寄生容量を用いることもできる。またトランジストの1次巻線Lpには直列に第1のインダクタLrと第2のインダクタLiを接続している。このインダクタLrとしてはトランジストの漏れインダクタンスを利用することもできる。

[0052] 第2のスイッチ回路S2には第5のキャパシタCrを直列に接続している。この第2のスイッチ回路SC2、第5のキャパシタCr、第1のインダクタLrおよびトランジストの1次巻線Lpとによって閉ループを構成している。また第1のスイッチ回路S1と第2のスイッチ回路S2との接続点に第2のインダクタLiの一端を接続し、その他端を第3のダイオードDiに接続している。また第2のスイッチ回路S2と第5のキャパシタCrとの接続点と、第3のダイオードDiと第2のインダクタLiとの接続点に、第4のダイオードDcの両端を接続している。

[0053] 第1のスイッチ回路S1と第3のキャパシタCaとの接続点と第1のインダクタLrの一端との間には第4のキャパシタCiを接続している。

[0054] 第1・第2のスイッチ回路S1, S2にはそれぞれスイッチング制御回路SC1, SC2を接続している。入力側整流回路Daと第4のキャパシタCiとの間に第4のダイオードDbを接続している。

[0055] スイッチング制御回路SC1は第1のスイッチ素子Q1のゲートソース間に接続したトランジスタTr1と遅延回路DL1と時定数回路TC1とを備えている。遅延回路DL1はコンデンサCg1と抵抗Rg1の直列回路およびスイッチ素子Q1の入力容量(不図示)によって構成している。第1のスイッチ素子Q1は駆動巻線Lb1の誘起電圧によってターンオンされるが、遅延回路DL1によってQ1のターンオンタイミングが遅延される。

[0056] 時定数回路TC1は、抵抗Rt1、ダイオードDt1、フォトカプラのフォトトランジスタPt1から成るインピーダンス回路とコンデンサCt1とからなる。この時定数回路TC1とトランジスタTr1とによって第1のスイッチ素子Q1のターンオフ制御を行う。

[0057] 第2のスイッチング制御回路SC2も第1のスイッチング制御回路SC1と同様の構成であり、同様に作用する。

[0058] 第1のスイッチング制御回路SC1のフォトカプラのフォトトランジスタPt1には帰還回路FB1を接続している。この帰還回路FB1は整流平滑回路RSから出力端子OUTへ出力される電圧Voを検出して、その電圧Voが安定化するように帰還制御する。第2の帰還回路FB2は第4のキャパシタCiの入力電圧Viを検出して、その入力電圧Viが軽負荷時に所定値より上昇しないように第2のスイッチ素子Q2のオン期間が制御されるように帰還制御する。但し、キャパシタCiの電圧Viを制御する必要がない場合は、帰還回路FB2は省略してもよい。

[0059] 第3のキャパシタCaは、スイッチ素子Q1, Q2のスイッチングによって生じる高周波電流を接地へ流す(シャントする)ので、その高周波電流が入力電源側へ戻るのを阻止する。また、インダクタ等を挿入して、そのインダクタンスとキャパシタCaのキャパシタンスとによってローパスフィルタを構成してもよい。

[0060] 次に、図1に示したスイッチング電源装置の回路動作について図2・図3を基に説明する。

図2は図1各部の波形図である。また、図3は商用電源の入力電圧Vin、入力電流in、インダクタLiに流れる電流ilの概略波形図である。スイッチ素子Q1, Q2のオンオフ信号(ゲート・ソース間電圧)をVgs1, Vgs2、ドレイン・ソース間電圧をVds1, Vds2、ドレイン電流をid1, id2、整流ダイオードDsの電流をis、インダクタLiに流れる電流をil、トランジスタの励磁電流をimとし、各状態の動作を示す。

[0061] (1) 状態1 state1 [t1→t2]

ダイオードD1またはスイッチQ1は導通しており、D1の導通時に駆動巻線Lb1の電圧によりQ1がターンオンしてZVS動作が行われる。1次巻線Lpには入力電圧Viが印加され励磁され、インダクタLiには全波整流電圧Vacが印加される。図2において αton はオン期間においてトランジスタの励磁電流imが負となる時間である。

[0062] 時刻t2でキャパシタCt1の電圧がトランジスタTr1のしきい値電圧となりTr1がオン、Q1がターンオフしてトランジスタの電圧(トランジスタの各巻線の電圧)が反転する。

[0063] (2) 状態2 state2 [t2→t3]

トランジスタの1次巻線Lp、インダクタLr、およびインダクタLiに流れている電流によりキャパシタCds1が充電され、キャパシタCds2が放電される。時刻t3で電圧Vds2が

零電圧となりダイオードD2が導通する。トランスTの2次側では電圧Vsが零になると整流ダイオードDsが導通する。

[0064] (3) 状態3 state3 [t3→t4]

ダイオードD2の導通時、駆動巻線Lb2の電圧によりスイッチQ2はターンオンしてZVS動作が行われる。トランスTの1次側ではインダクタLrとキャパシタCrが共振し、インダクタLiに蓄えられた励磁電流ilによりキャパシタCiが充電される。トランスTの2次側ではトランスTの励磁エネルギーが2次巻線Lsから放出され、ダイオードDsに流れ電流isは曲線波形となる。図2において、tr1はトランスTのリセット時間である。時刻t4で(t3からtr2経過後)電流ilが零となると、キャパシタCiの充電は終了する。

[0065] (4) 状態4 state4 [t4→t5]

電流ilが零となると、ダイオードDcが導通して、スイッチ素子Q2とともにインダクタLiの両端が短絡され、ダイオードDiへの印加電圧がクランプされる。状態3、状態4ではキャパシタCrの電圧Vrは1次巻線LpとインダクタLrとの直列回路に印加され、励磁電流imは直線的に減少する。励磁電流imは零となると負電流となり、状態1とは逆方向に1次巻線Lpを励磁する。2次側では、電流isが零となるまで流れる。時刻t5でキャパシタCt2の電圧がTr2のしきい値電圧となりTr2がオンすると、スイッチQ2がターンオフする。

[0066] (5) 状態5 state5 [t5→t6]

トランスTの2次側ではダイオードDsに逆電圧が印加されトランスTの2次巻線Lsの電圧が反転する。1次側では1次巻線LpとインダクタLrに流れていた電流によりキャパシタCds1が放電され、キャパシタCds2が充電され、時刻t6で電圧Vds1が零になるとD1が導通する。

以上の状態1～5を繰り返す。

[0067] 図1に示したスイッチング電源装置の回路特性は次のとおりである。

スイッチ素子Q1またはダイオードD1が導通している期間をtonとし、スイッチ素子Q2またはダイオードD2が導通している期間をton2とし、1周期をT、商用電源電圧の絶対値(商用電源の整流電圧)をVacとし、トランスTの2次巻線Lsの巻線数に対する1次巻線Lpの巻線数の比をnとすると、トランスTに印加される電圧積より次式が

成り立つ。

[0068] $V_i \times t_{on} = nV_o \times t_{on2}$ …(1)

また、インダクタLiに印加される電圧積より次式が成り立つ。

[0069] $V_{ac} \times t_{on} = (V_i + nV_o - V_{ac}) \times t_{r2}$ …(2)

上式において、時間 t_{r2} は、インダクタLiに流れる電流 i_l がオフ期間において零となるまでの時間である。1商用電源電圧周期において、電圧 V_i と出力電圧 V_o はほぼ一定であるから、(1)式より t_{on} を制御して、 t_{on}/t_{on2} または時比率 t_{on}/T を制御すれば出力電圧を安定化することができる。

[0070] また、瞬時入力電力 p は、昇圧コンバータの一般式より次式で求まる。

[0071]
$$p = (V_{ac} \cdot t_{on})^2 (V_i + nV_o) / \{2L_i T (V_i + nV_o - V_{ac})\}$$
 …(3)

ここで、(3)式に(1)式を代入して整理すると、

$$p = (V_{ac} \cdot nV_o)^2 / \{2L_i V_i (V_i + nV_o - V_{ac})\} \times t_{on2}$$
 …(4)

と表され、入力電力 p は時間 t_{on2} に比例することが分かる。

[0072] また、(4)式より t_{on2} を一定とすると、入力電力 p が小さくなる程、電圧 V_i が大きくなることが分かる。よって(4)式より、 t_{on2} を制御して電圧 V_i を安定化できることが導かれる。

[0073] さらに、(2)式で決まる t_{r2} が t_{on2} よりも短い場合において、インダクタLiに流れる電流ピーク値 I_{lp} は次式で表される。

[0074] $I_{lp} = (V_{ac} / L_i) \times t_{on}$ …(5)

ここで、1商用電源電圧周期においてオン期間 t_{on} はほぼ一定であるから、 $t_{on2} > t_{r2}$ を満たす場合、電流ピーク値 I_{lp} は全波整流電圧 V_{ac} に比例し、図3に示すように、商用交流電源の入力電流 i_{in} はほぼ正弦波となり、入力電流の高調波成分が大幅に低減されるとともに力率が向上する。

[0075] また、1商用電源電圧周期においてオン期間 t_{on} はほぼ一定となることから、出力電圧を安定化する制御回路の応答特性は良く、さらに、キャパシタ C_i に蓄えられた静電エネルギーにより、十分な出力電圧保持時間が確保できることが分かる。

[0076] さらに、高周波のスイッチング電流であるインダクタLiに流れる電流は、キャパシタCaを通って流れるため、入力側整流回路Daには流れず、従来、入力側整流回路を構成する整流素子により発生していた逆回復時間や逆電圧等の要因による電力損失を大幅に低減することができる。

[0077] 図1に示したスイッチング電源装置の効果はまとめると次のとおりである。

(1)スイッチ素子Q1, Q2はZVS動作により、スイッチング損失が大幅に低減される。

[0078] (2)ダイオードDiにはスイッチング電流が流れ、このスイッチング電流がキャパシタCaに流れることにより、整流回路Daにはスイッチング電流が流れず、損失を低減できる。また、ダイオードDiはスイッチング周波数に対応した高速動作が要求されるが、整流回路Da, Dbは商用電源周波数に対応した低速動作の一般ダイオードで対応できる。

[0079] (3)スイッチ素子Q1がオフの期間にダイオードDcとスイッチ素子Q2でインダクタLiを短絡することによりインダクタLiに流れる電流が零になり、逆方向に電圧が印加されるのが抑制されるため、ダイオードDiに印加される電圧を大幅に低減できる。

[0080] (4)出力電圧Voは、帰還回路FB1の信号に基づいてスイッチ素子Q1のオン期間を制御することにより安定化制御される。

[0081] (5)入力電圧Viは、帰還回路FB2の信号に基づいてスイッチ素子Q2のオン期間を制御することにより制御される。このため、軽負荷時や無負荷時での入力電圧Viの上昇を抑制できる。

[0082] 次に、第2の実施形態に係るスイッチング電源装置について、図4を基に説明する。

図4はその回路図である。図1に示したスイッチング電源装置と異なり、この例では第2のスイッチ回路S2と第5のキャパシタCrの直列回路を第1のスイッチ回路S1に対して並列に接続している。その他の構成は図1に示したものと同様である。なお図4ではトランジスタの駆動巻線Lb1, Lb2、帰還回路FB1, FB2については図示を省略している。またスイッチング制御回路SC1, SC2はブロック化して表している。

[0083] このような回路構成であっても第1の実施形態の場合と同様の効果を奏する。また

キャパシタCrの印加電圧は大きくなるが、蓄える電荷量を一定として考えると、キャパシタCrの容量を低減できるため、キャパシタCrの小型化を図ることができる。

[0084] 図5は第3の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。図1に示した構成と異なり、この図5に示す例では、第5のキャパシタCrを第4のキャパシタCiの一端と第1のインダクタLrとの間に接続している。また図1に示したダイオードDcをダイオードDiのカソードとスイッチ素子Q2のドレインとの間に接続することができるが、それは省略している。その他は図1に示した場合と同様である。ただし図5ではトランジスタTの駆動巻線Lb1, Lb2、スイッチング制御回路SC1, SC2および帰還回路FB1, FB2については図示を省略している。

[0085] このような構成であっても第1の実施形態の場合と同様の効果が得られる。また、第1のインダクタLrに直列につながる第5のキャパシタCrと第4のキャパシタCiとの接続点に第2のスイッチ素子Q2の一端を接続したので第1・第2のスイッチ素子Q1, Q2の印加電圧を低減でき、それらの電圧ストレスを低減できる。

[0086] 図6は第4の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。図1に示したスイッチング電源装置と異なり、この図6に示す例では、図1に示した第4のダイオードDbを設けていない。図1に示した第4のダイオードDbは、それを設けることによって第4のキャパシタCiに充電電流を供給できるが、このダイオードDbとキャパシタCiとは所謂コンデンサインプット型の整流平滑回路を構成しているのではない。コンデンサCiはトランジスタTの1次巻線LpおよびインダクタLrによって充電される。したがって図1に示したダイオードDbは必須ではない。この図6の構成ではダイオードDbが不要となって部品点数の削減が図れる。ただ、このスイッチング電源装置の起動時や重負荷時においてコンデンサCiの両端電圧がコンデンサCaの両端電圧より小さい状態でコンデンサCiを充電する電流がトランジスタTを通るためトランジスタTが偏磁する場合があるが、図1に示したようにダイオードDbを設ければ、起動時や重負荷時にコンデンサCiに対して直接充電できるため、上述の問題が生じない。

[0087] 図7は第5の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。図1に示した例では第2のインダクタLiを第1・第2のスイッチ回路S1, S2の接続点と第3のダイオードDiとの間に設けたが、この図7の例では第1のスイッチ回路S1とキャパシタCiとの

接続点とキャパシタCaとの間に第2のインダクタLiを設けている。このような構成であっても第1の実施形態の場合と同様の効果が得られる。

[0088] 図8は第6の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。この例ではトランジストTとは別に第2のトランジストT2を設け、この第2のトランジストT2の入力巻線Liを図1に示した第2のインダクタLiとして用いている。そして第2のトランジストT2の出力巻線Loと整流平滑回路RSとの間に整流回路Ds2を設けている。その他の部分は図1に示したものと同様である。なお図1におけるダイオードDbに相当するものは図8では図示していない。

[0089] このような構成により、インダクタLiに蓄えられたエネルギーがトランジストT2の出力巻線Loから整流平滑回路RS側に供給できるため、その分トランジストTの電流が減少し、トランジストTの巻線等による導通損失が低減して、さらなる高効率化が図れる。なお、整流回路Ds2と整流回路Dsを切り放して、異なる出力として供給することも可能である。

[0090] 図9は第7の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。この例では第2のトランジストT2を設け、その入力巻線Li1に対して直列にインダクタLiを設けている。その他の部分は図8に示したものと同様である。

[0091] このような構成により、インダクタLi1に蓄えられるエネルギーが整流平滑回路RS側に直接供給できるため、その分トランジストTの電流が減少し、トランジストTの巻線等による導通損失が低減して高効率化が図れる。なお、図8の場合と同様に、整流回路Ds2と整流回路Dsを切り放して、異なる出力として供給することも可能である。

[0092] 図10は第8の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。この例ではトランジストTに3次巻線Ltを設け、この3次巻線Ltを第2のインダクタLiと直列に接続している。その他は図1に示したものと同様である。

[0093] この図10に示すような構成によって第1の実施形態の場合と同様の効果を得ることができるとともに、トランジストTの3次巻線Ltに発生する電圧を利用してインダクタLiに印加される電圧を調整して入力電流iinの導通角(商用電源電圧の半周期内での導通期間)を調整して高調波電流の抑制と損失低減を両立することができる。また、3次巻線Ltと1次巻線との巻数比を調整することにより上記導通角を狭めてキャパシタCiへ

過大な電圧が印加されるのを抑制できる。

[0094] 図11は第9の実施形態に係るスイッチング電源装置の回路図である。この例ではインダクタLiをダイオードDbとキャパシタCaとの間に設けている。また整流平滑回路RSにダイオードDfとインダクタLfを追加してフォワードコンバータ形式としている。したがってトランジストの2次巻線Lsの極性は第1ー第8の実施形態の場合と逆である。その他の構成は図1に示したものと同様である。この図11に示した構成によれば、インダクタLfに励磁エネルギーを蓄積するため、その分トランジストを小型化できる。

[0095] なお、インダクタLiの位置を変えずに、2次側を図1のようにフライバックコンバータ形式とすることも可能である。さらに、図1、図4ー図10において2次側を図11同様にフォワードコンバータ形式とすることも可能である。

[0096] 図12は第10の実施形態に係るスイッチング電源装置のスイッチング制御回路の構成例を示している。この例ではトランジストの駆動巻線Lbに抵抗Rz、ツェナダイオードZD、ダイオードDzの直列回路を接続していて、ツェナダイオードZDとダイオードDzとの直列回路に抵抗RtとキャパシタCtによる直列回路を並列に接続している。そしてキャパシタCtの電圧をトランジスタTrのベースに印加するようにしている。またトランジスタTrのベース・エミッタ間に設けたダイオードDbは、トランジスタTrのベース・エミッタ間への逆電圧の印加を防止する。

[0097] 抵抗RgとキャパシタCgの直列回路は遅延回路DLを構成していて、スイッチ素子Qのターンオンを遅延させる。なおキャパシタCissはスイッチ素子Qの入力容量を図示している。

[0098] このように、抵抗RtとキャパシタCtからなる時定数回路にはツェナダイオードZDによる一定電圧が供給されるので、駆動巻線Lbの電圧変動の影響を受けない。またこの抵抗Rtのインピーダンスを制御することによって、トランジスタTrがオンするタイミング、すなわちスイッチ素子Qのオン期間を制御することができる。

請求の範囲

[1] 第1のスイッチ素子Q1、第1のダイオードD1、および第1のキャパシタCds1の並列接続回路で構成された第1のスイッチ回路S1と、
第2のスイッチ素子Q2、第2のダイオードD2、および第2のキャパシタCds2の並列接続回路で構成された第2のスイッチ回路S2と、
交流入力電圧を整流する少なくとも1つの整流素子により構成された入力側整流回路Daと、該整流回路Daにより整流された電圧が印加される第3のキャパシタCaと、
1次巻線Lpと2次巻線Lsを有するトランストと、
前記2次巻線Lsに接続された整流平滑回路RSと、
前記1次巻線Lpに直列に接続された第1のインダクタLrと、
第1のスイッチ回路S1が導通状態となるオン期間に第3のキャパシタCaの電圧が印加されるように接続された第2のインダクタLiと、
該第2のインダクタLiに逆電流が流れるのを阻止する第3のダイオードDiと、
第2のインダクタLiに蓄えられた励磁エネルギーにより充電され、且つ、前記オン期間に前記1次巻線Lpに電圧を印加するように接続された第4のキャパシタCiと、
第1のインダクタLrと前記1次巻線Lpと第2のスイッチ回路S2とともに閉ループを構成する第5のキャパシタCrと、
第1・第2のスイッチ素子を両スイッチ素子が共にオフする期間を挟んで交互にオンオフ駆動するスイッチング制御回路SC1、SC2とを備えたことを特徴とするスイッチング電源装置。

[2] 第1のスイッチ素子Q1、第1のダイオードD1、および第1のキャパシタCds1の並列接続回路で構成された第1のスイッチ回路S1と、
第2のスイッチ素子Q2、第2のダイオードD2、および第2のキャパシタCds2の並列接続回路で構成された第2のスイッチ回路S2と、
交流入力電圧を整流する少なくとも1つの整流素子により構成された入力側整流回路Daと該整流回路Daにより整流された電圧が印加される第3のキャパシタCaと、
1次巻線Lpと2次巻線Lsを有するトランストと、
前記2次巻線Lsに接続された整流平滑回路RSと、

前記1次巻線L_pに直列に接続された第1のインダクタL_rと、
第1のスイッチ回路S₁が導通状態となるオン期間に第3のキャパシタC_aの電圧が
印加されるように接続された第2のインダクタL_iと、
該第2のインダクタL_iに逆電流が流れるのを阻止する第3のダイオードD_iと、
第2のインダクタL_iに蓄えられた励磁エネルギーにより充電され、且つ、前記オン期
間に前記1次巻線L_pに電圧を印加するように接続された第4のキャパシタC_iと、
第1のスイッチ回路S₁の両端に接続される直列回路を第2のスイッチ回路S₂とで構
成する第5のキャパシタC_rと、
第1・第2のスイッチ素子を両スイッチ素子が共にオフする期間を挟んで交互にオン
オフ駆動するスイッチング制御回路SC₁, SC₂とを備えたことを特徴とするスイッchin
グ電源装置。

[3] 前記トランスTとは別の第2のトランスT₂を設け、第2のインダクタL_iを第2のトランス
T₂の入力巻線で構成し、第2のトランスT₂の出力巻線L_oと前記整流平滑回路RSとの間に整流回路D_{s2}を設けたことを特徴とする請求項1または2に記載のスイッchin
グ電源装置。

[4] 前記トランスTとは別の第2のトランスT₂を設け、第2のインダクタL_iと直列に第2のト
ラスT₂の入力巻線L_{i1}を接続し、第2のトランスT₂の出力巻線L_oと前記整流平滑
回路RSとの間に整流回路D_{s2}を設けたことを特徴とする請求項1または2に記載の
スイッchin
グ電源装置。

[5] 前記トランスTに3次巻線L_tを設け、該3次巻線L_tに第2のインダクタL_iを直列に接
続したことを特徴とする請求項1または2に記載のスイッchin
グ電源装置。

[6] 第3のキャパシタC_aが高調波成分の電流を流してローパスフィルタまたはローパス
フィルタの一部を構成することを特徴とする請求項1ー5のいずれかに記載のスイッchin
グ電源装置。

[7] 前記入力側整流回路D_aと第4のキャパシタC_iとの間に第4のダイオードD_bを接続
したことを特徴とする請求項1ー6のいずれかに記載のスイッchin
グ電源装置。

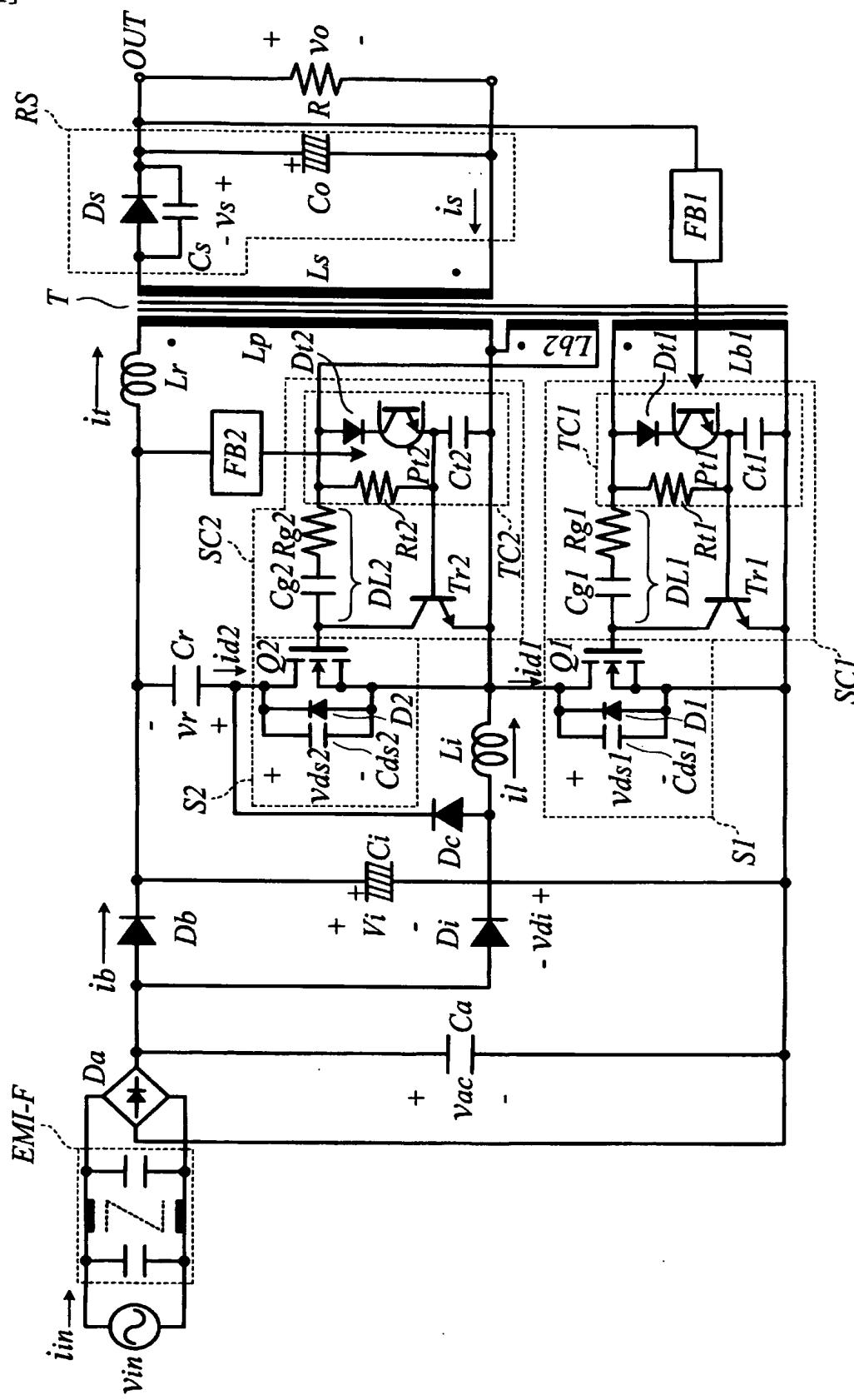
[8] 第1のスイッチ回路S₁と第2のスイッチ回路S₂との接続点に第2のインダクタL_iの一
端を接続し、他端を第3のダイオードD_iに接続し、第2のスイッチ回路S₂と第4のキャ

パシタCrとの接続点と、第1のスイッチ回路S1と第2のスイッチ回路S2との接続点に、第4のダイオードDcの両端を接続したことを特徴とする請求項1～7のいずれかに記載のスイッチング電源装置。

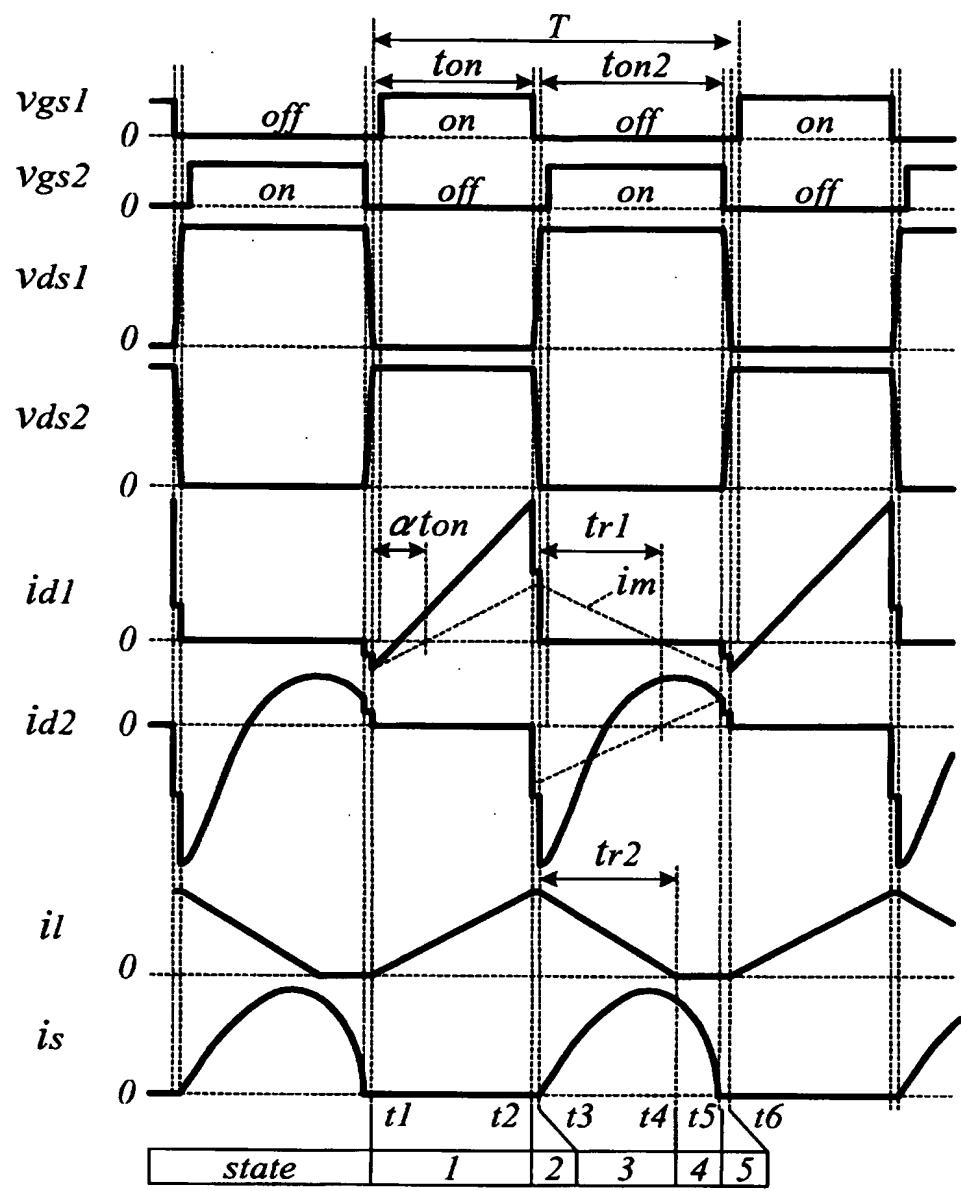
- [9] 前記トランスTに単数または複数の駆動巻線Lb1, Lb2を設け、前記スイッチング制御回路SC1, SC2は、前記駆動巻線Lb1, Lb2に発生する電圧を用いて第1のスイッチ素子Q1または第2のスイッチ素子Q2を駆動することを特徴とする請求項1～8のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
- [10] 前記駆動巻線Lb1, Lb2と第1・第2のスイッチング素子Q1, Q2の制御端子との間に抵抗Rg1, Rg2とコンデンサCg1, Cg2との直列回路からなる遅延回路DL1, DL2を備え、前記スイッチング制御回路SC1, SC2は、前記駆動巻線Lb1, Lb2に前記スイッチ素子Q1, Q2をターンオンさせる電圧が発生してから遅延して該スイッチ素子Q1, Q2をそれぞれターンオンさせることを特徴とする請求項1～9のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
- [11] 第1・第2のスイッチ素子Q1, Q2の両端に印加される電圧が零電圧または零電圧付近まで低下してからターンオンするように前記遅延回路DL1, DL2の遅延時間をそれぞれ設定したことを特徴とする請求項10に記載のスイッチング電源装置。
- [12] 前記スイッチング制御回路SC1, SC2は、前記駆動巻線Lb1, Lb2に前記スイッチ素子Q1, Q2をターンオンさせる電圧が発生してから所定時間後にオンすることにより前記スイッチ素子Q1, Q2をターンオフさせる、前記スイッチ素子Q1, Q2の制御端子に接続されたスイッチ手段を備えることを特徴とする請求項1～11のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
- [13] 前記スイッチ手段をトランジスタTr1, Tr2で構成し、該トランジスタTr1, Tr2の制御端子に時定数回路を構成するインピーダンス回路およびコンデンサCt1, Ct2がそれぞれ接続されたことを特徴とする請求項12に記載のスイッチング電源装置。
- [14] 前記スイッチング制御回路SC1, SC2は、前記駆動巻線Lb1, Lb2に前記スイッチ素子Q1, Q2をターンオンさせる電圧が発生してから、一定時間後に前記スイッチ素子Q1, Q2をターンオフさせるように時定数回路TC1, TC2を備えたことを特徴とする請求項1～13のいずれかに記載のスイッチング電源装置。

- [15] 前記トランスTの有する漏れインダクタンスを第1のインダクタL_rとして構成したことを特徴とする請求項1ー14のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
- [16] 第1のスイッチ回路S1または第2のスイッチ回路S2の少なくとも一方を電界効果トランジスタで構成したことを特徴とする請求項1ー15のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
- [17] 前記スイッチング制御回路SC1, SC2は、前記2次巻線L_sに接続された整流平滑回路RSから得られる出力電圧を安定化するように第1のスイッチ素子Q1のオン期間を制御することを特徴とする請求項1ー16のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
- [18] 前記スイッチング制御回路SC1, SC2は、第4のキャパシタC_iの両端電圧に応じて第2のスイッチ素子Q2のオン期間を制御することを特徴とする請求項1ー17のいずれかに記載のスイッチング電源装置。
- [19] 前記スイッチング制御回路SC1, SC2は、第4のキャパシタC_iの両端電圧の上昇に応じて第2のスイッチ素子Q2のオン期間を抑制し、軽負荷または無負荷時に発振期間と停止期間を周期的に繰り返す間欠発振動作モードに移行して、第4のキャパシタC_iの両端電圧の上昇を抑制することを特徴とする請求項1ー18のいずれかに記載のスイッチング電源装置。

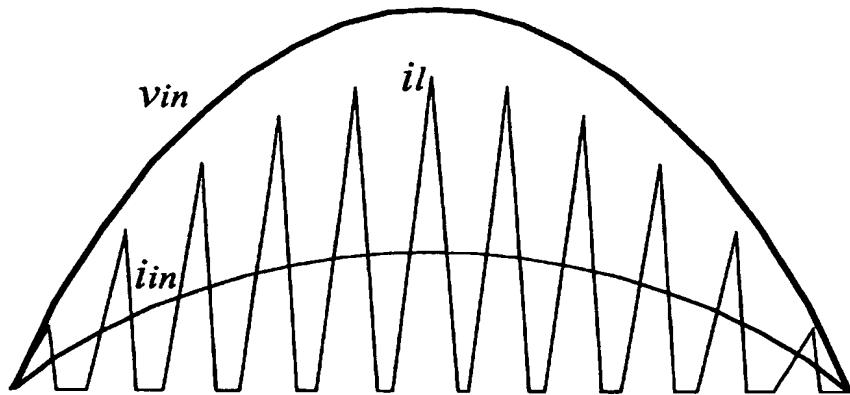
[図1]



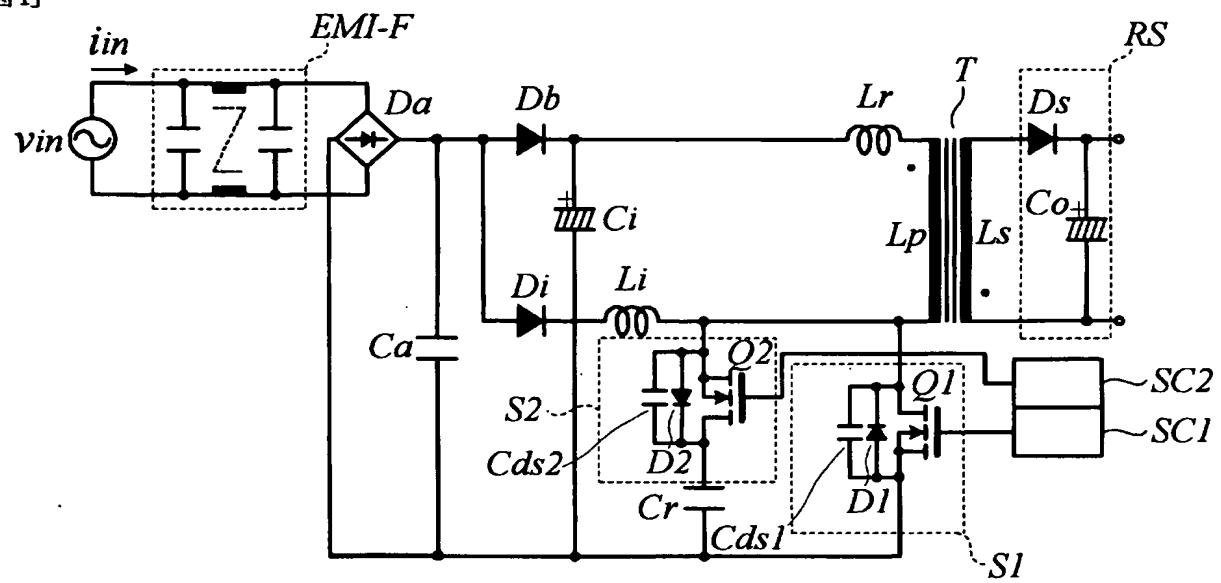
[図2]



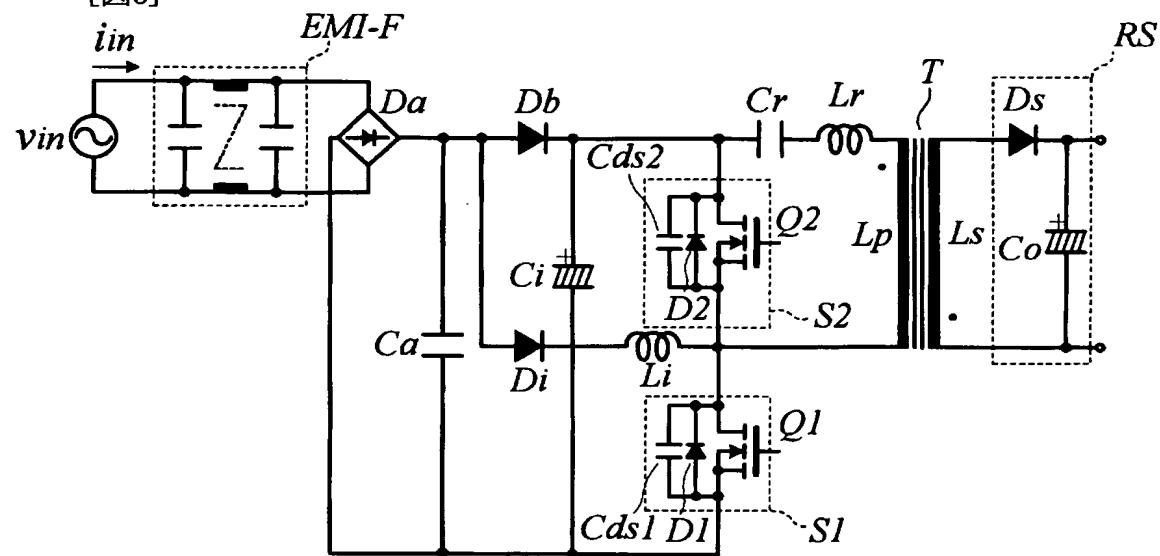
[図3]



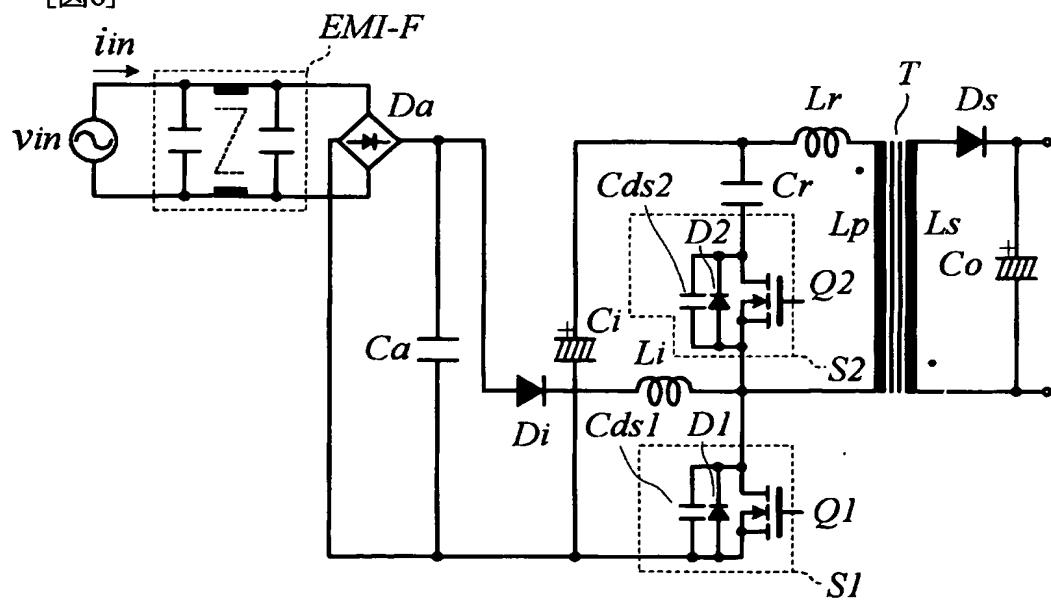
[図4]



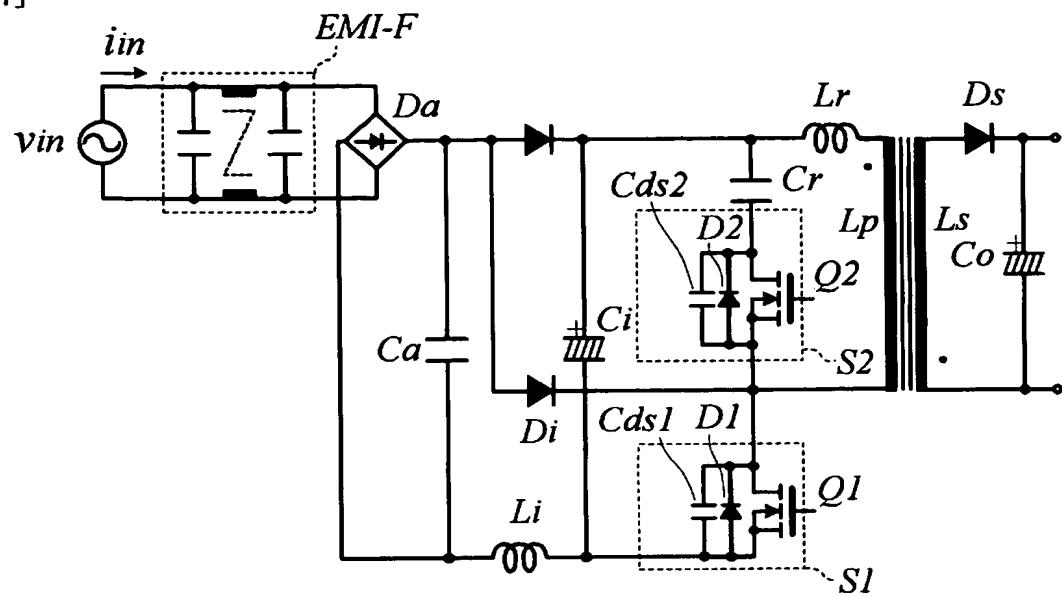
[図5]



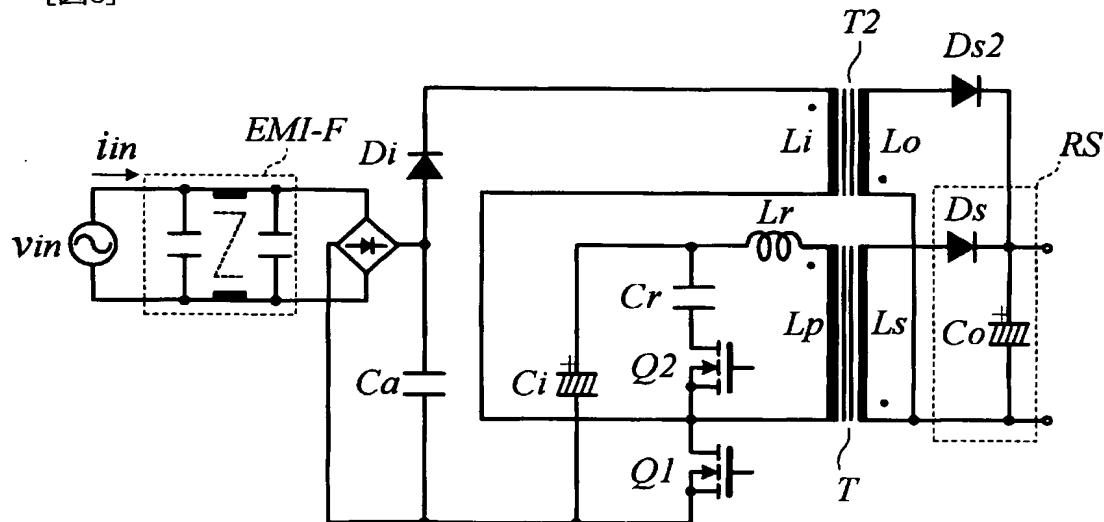
[図6]



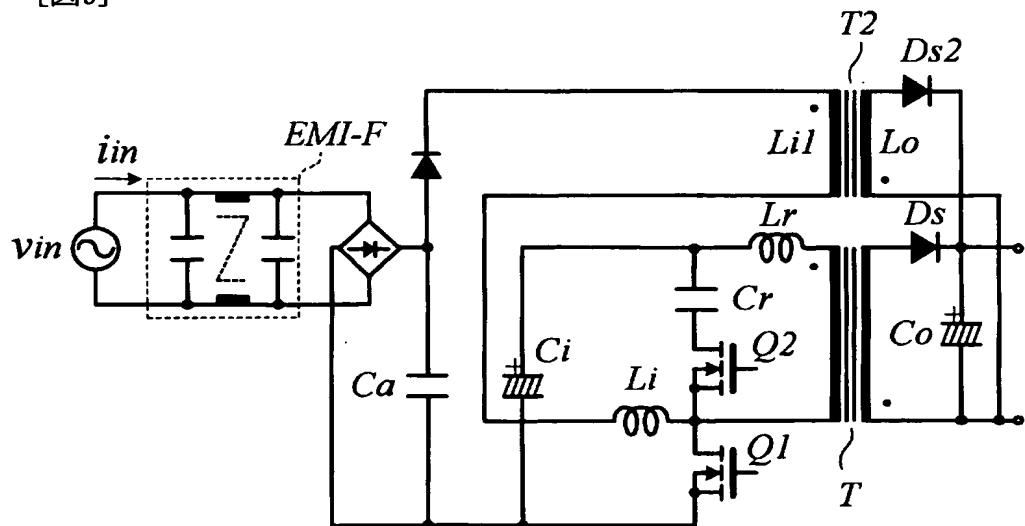
[図7]



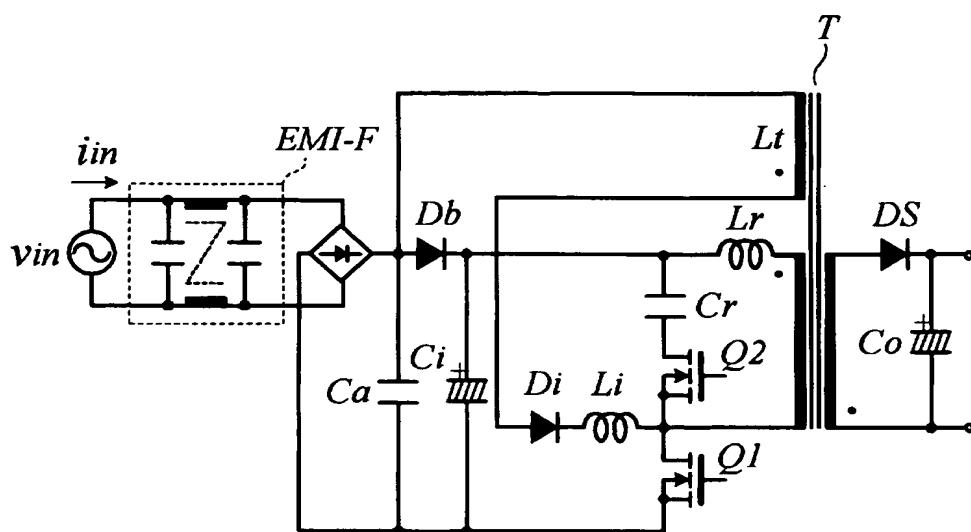
[図8]



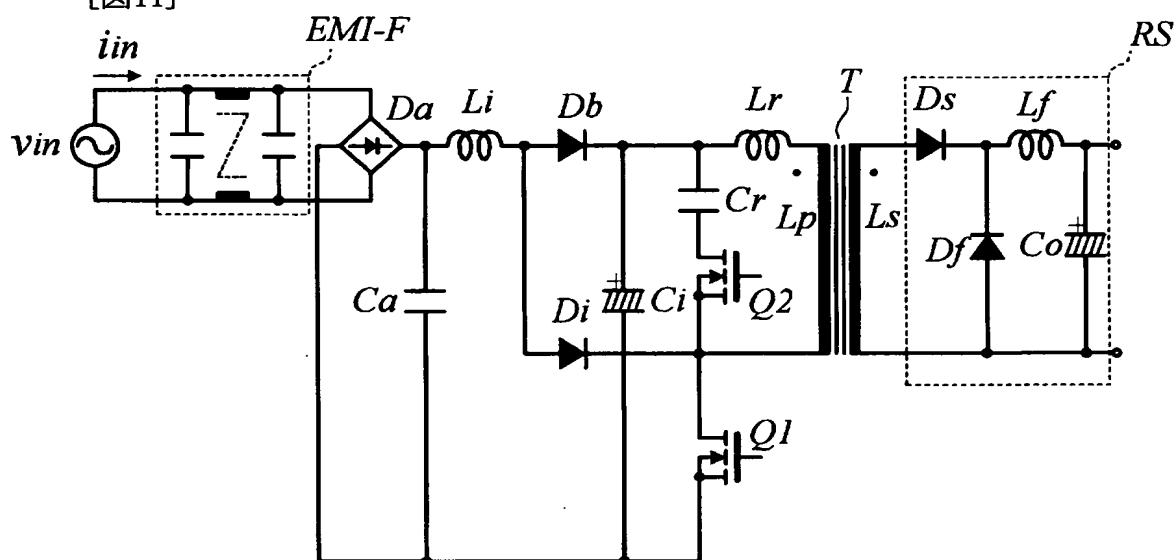
[図9]



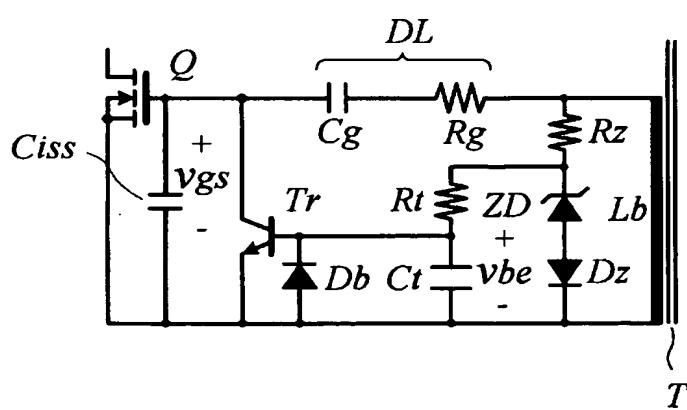
[図10]



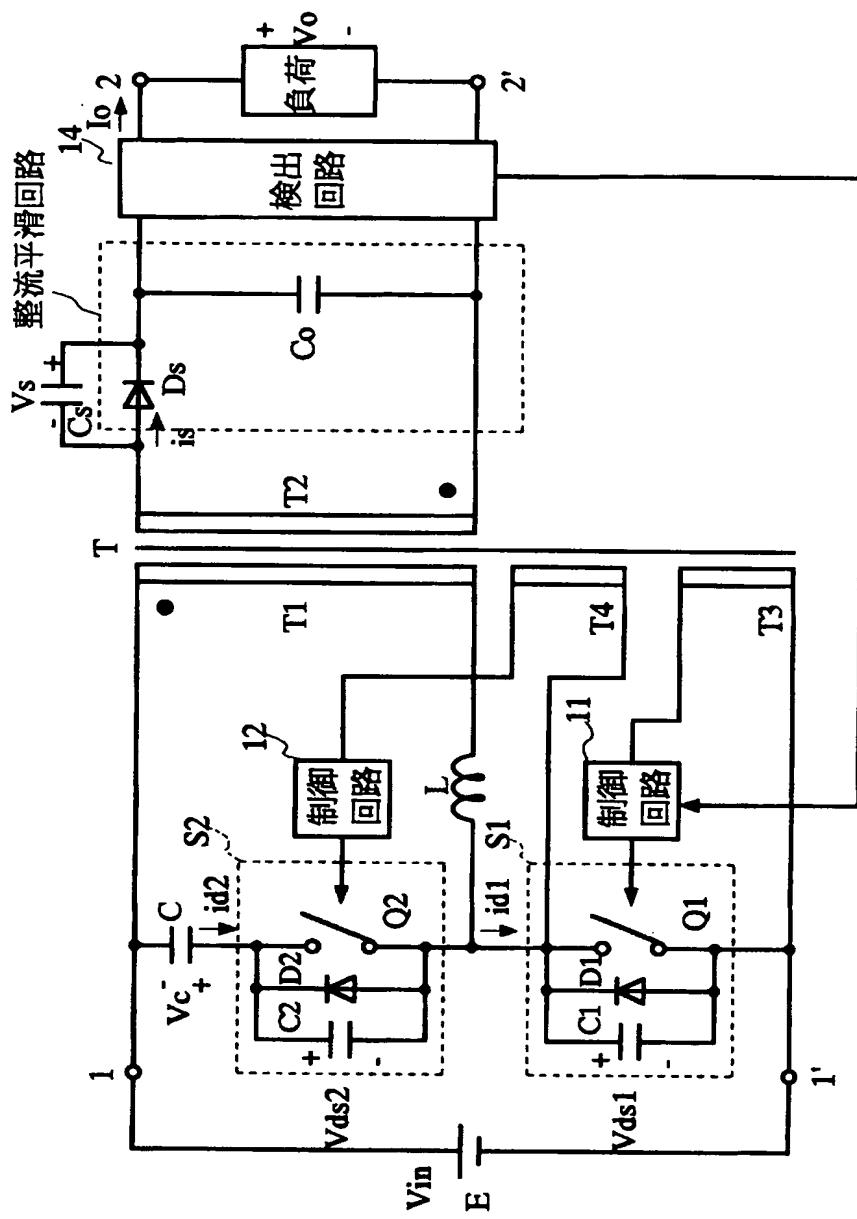
[図11]



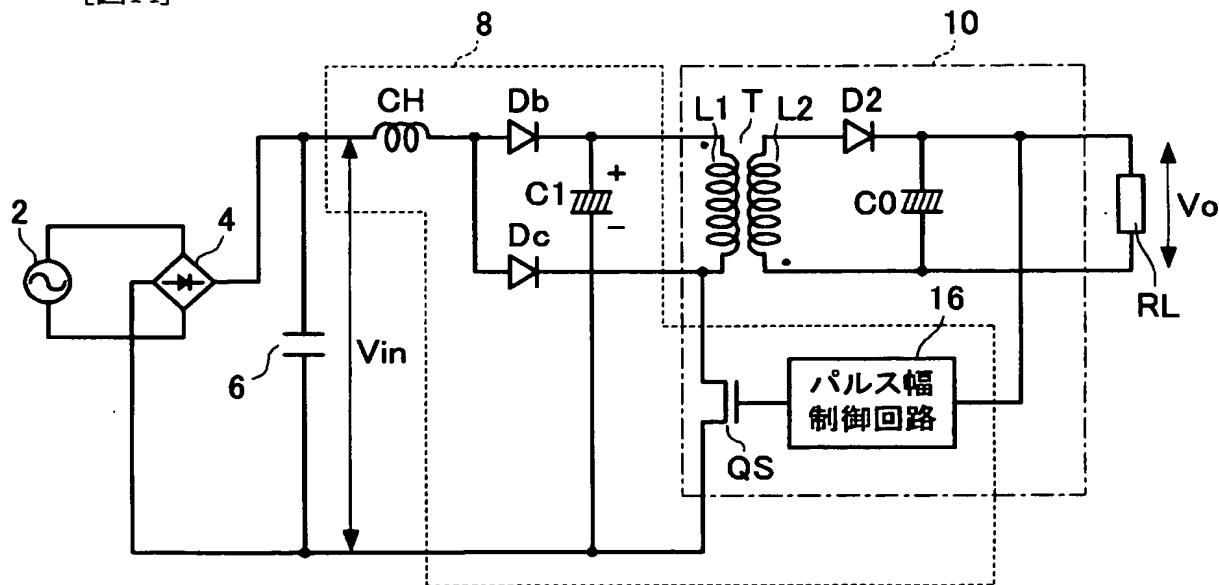
[図12]



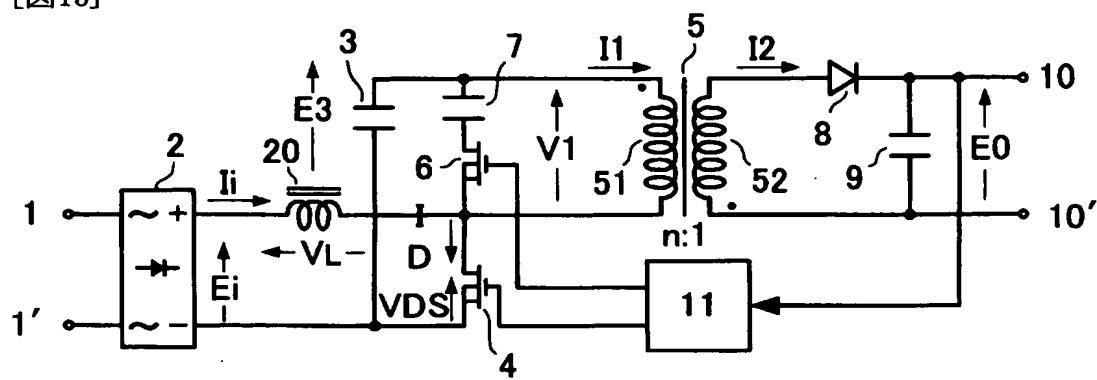
[図13]



[図14]



[図15]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/016103

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
Int.Cl⁷ H02M3/28

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
Int.Cl⁷ H02M3/28

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched
 Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2005
 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2005 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2005

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2003-224972 A (Murata Mfg. Co., Ltd.), 08 August, 2003 (08.08.03), & US 2003/0142521 A1 & CN 1434562 A & GB 2388258 A	1-19

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

* Special categories of cited documents:	
"A"	document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
"E"	earlier application or patent but published on or after the international filing date
"L"	document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
"O"	document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
"P"	document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
"T"	later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
"Y"	document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
"&"	document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
07 January, 2005 (07.01.05)

Date of mailing of the international search report
25 January, 2005 (25.01.05)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int. Cl' H02M 3/28

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int. Cl' H02M 3/28

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2005年
 日本国登録実用新案公報 1994-2005年
 日本国実用新案登録公報 1996-2005年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
A	JP 2003-224972 A (株式会社村田製作所) 08.08.2003 & US 2003/0142521 A1 & CN 1434562 A & GB 2388258 A	1-19

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

07.01.2005

国際調査報告の発送日

25.1.2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号 100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

川端 修

3V 8718

電話番号 03-3581-1101 内線 3356